

DG0R7V60

600V 1.0A

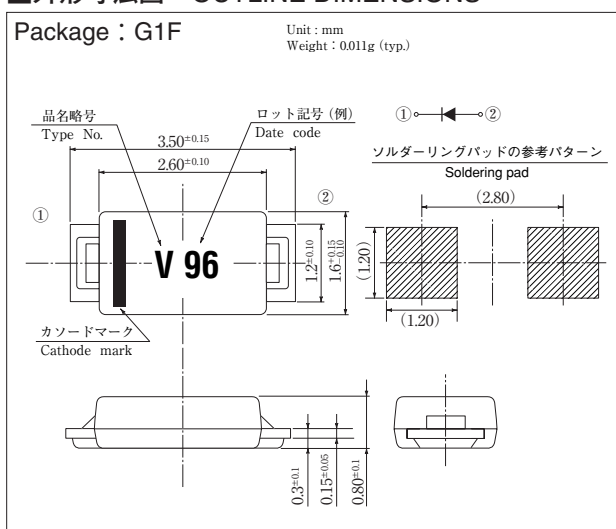
特長

- 耐湿性に優れ高信頼
- 自動実装対応

Feature

- High-Reliability
- for Auto-Mount

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DG0R7V60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Ta=29°C *1	0.55	A
			Ta=59°C *2	0.7	
			Tl=126°C	1.0	
せん頭サーージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25°C		15	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms Tj=25°C		1.0	A ² s

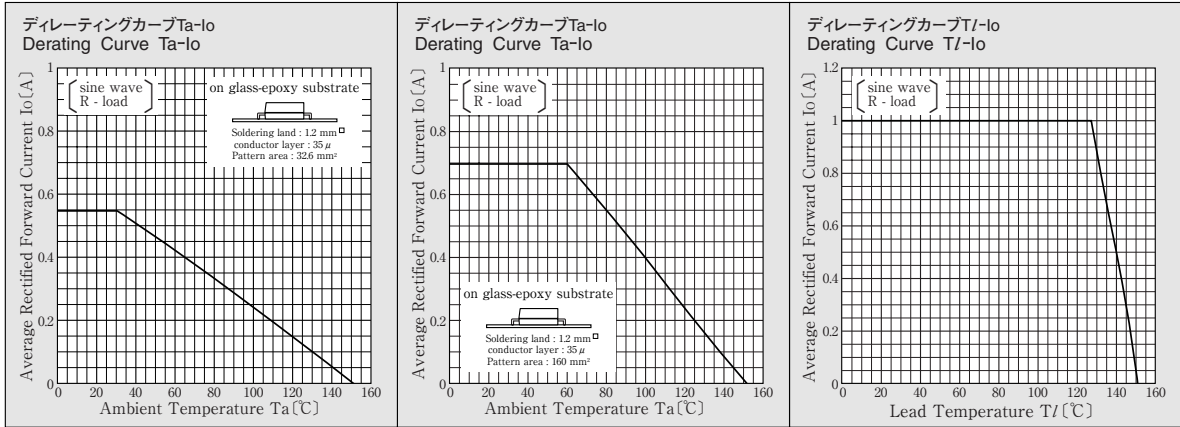
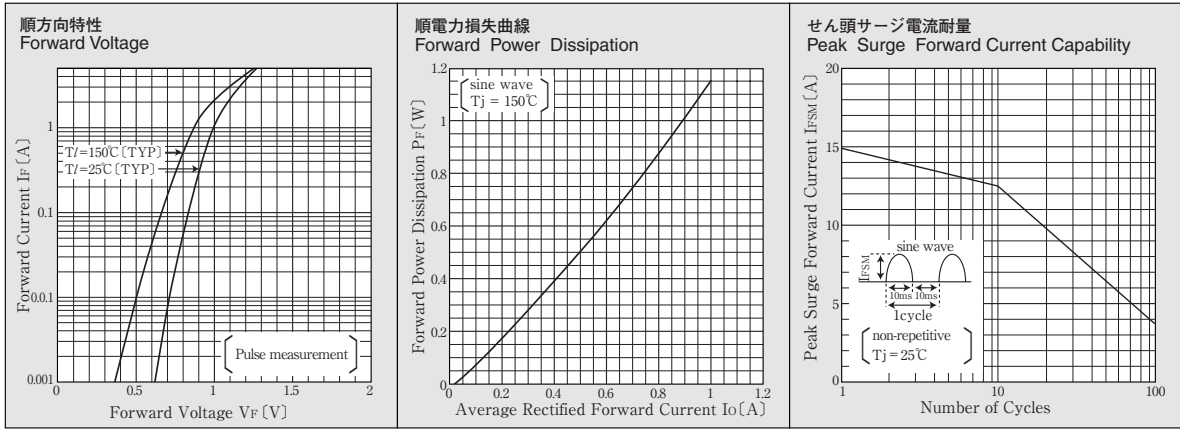
●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =0.7A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =600V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	*1 MAX 210	
		接合部・リード間, アルミナ基板実装 Junction to Lead, On alumina substrate	*2 MAX 120	
	θ _{jl}	接合部・リード間, アルミナ基板実装 Junction to Lead, On alumina substrate	MAX 20	

*1: ガラエポ基板実装 (1インチ基板) 銅箔パターン総面積32.6mm²
Measured on the 1 inch phenol substrate (pattern area: 32.6mm²)

*2: ガラエポ基板実装 (1インチ基板) 銅箔パターン総面積160mm²
Measured on the 1 inch phenol substrate (pattern area: 160mm²)

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.